Cバンド 20K 冷却高電界 RF 電子銃による 高品質電子ビーム引き出しの可能性

日本大学量子科学研究所電子線利用研究施設 田中俊成,境武志,早川建,早川恭史,野上杏子, 住友洋介,山田靖征,吉田昂斗,佐藤勇

研究の背景と動機

光・量子融合連携開発研究プログラム 「小型加速器による小型高輝度X線源とイメージング基盤技術開発」 (KEK 浦川、照沼氏)

クライオ光陰極高周波電子銃開発(日大、KEK)

20K程度までの冷却は素人でも容易

■ 常伝導だが表面抵抗の低下を利用した低損失空洞

■ 大電力RF試験による動作の検証はプログラムでは未達成

SLACにおける Xバンド空洞の高電界試験結果

■ 銅合金による高硬度材料空洞による高電界での低放電頻度

45K冷却純銅空洞において、さらに高電界でも低放電頻度を達成

■ 放電頻度の電界強度依存性に対する欠陥モデルとの整合性

トヤマ・KEKによるクライオ進行波加速管の開発と大電力試験
 低温下において電界放出電子が少ない

2.6セルCバンド光陰極RF電子銃用低電力試験空洞







2.6セルCバンド光陰極RF電子銃用低電力試験空洞



低電力試験に基づくRF電子銃空洞の仕様

共振周波数	5712	MHz
加速空洞長	68.2	mm
無負荷Q値	73000	
結合係数	19.7	
負荷Q値	3526	
電場立上り時間	196	ns
シャントインピーダンス	624	M Ω /m
ピーク入力RF電力	4	MW
パルス幅	2	μs
繰返し	50	pps
平均空洞損失	73.6	W
バンチ当たり電荷量	0.5	nC
最大表面電界	162	MV/m
最大カソード面電界	116	MV/m
加速勾配	83	MV/m

大電力RF(>4 MW)入力時の2.6セル空洞内における高電界発生



V. Dolgashev, 2nd European Advanced Accelerator Concepts Workshop (EAAC 2015) La Biodola, Isola d'Elba, Italy, 13-19 September 2015

銅表面をカソードとした場合の量子効率とエミッタンス

1

銅表面付近のポテンシャルエネルギー $\phi(x) = -eE_{RF}x - \frac{e^2}{16\pi\varepsilon_0 x}$ ポテンシャルエネルギー最大値 $\phi_{max} = -\sqrt{e^3 E_{RF}/4\pi\varepsilon_0}$ 仕事関数実効値 $\phi_{eff} = \phi_W - \sqrt{e^3 E_{RF}/4\pi\varepsilon_0}$

D. H. Dowell *et al.,* Phys. Rev. STAB 9(2006) 063502 量子効率

$$QE(\omega) = \frac{1 - R(\omega)}{1 + \lambda_{opt}(\omega)/\lambda_{e-e}(\omega)} \frac{E_F + \hbar\omega}{2\hbar\omega} \left[1 - \sqrt{\frac{E_F + \phi_{eff}}{E_F + \hbar\omega}} \right]^2$$

規格化エミッタンス
 $\varepsilon_n = \sigma_x \sqrt{\frac{\hbar\omega - \phi_{eff}}{3mc^2}}$
 $\lambda_p = 266 \text{ nm で試算}$



大電力入力による空洞特性への影響 - 温度上昇 -

CST Studio Simulation



Magnetic Field Distribution

- ・左端板中心軸から17mmで磁場が最大
- ・外周部ではその90% → 損失電力は81%





 $\frac{dP}{dA} = \frac{1}{2} R_s J^2 = \frac{1}{2} R_s |H_{\parallel}|^2 (単位面積当たり発熱)$ $\rho: 密度, C_{\rm P}: 比熱, K: 熱伝導率$



RRR=3000 高純度銅の空洞表面抵抗 R_s

大電力入力による空洞特性への影響 - 温度上昇 -



大電力入力による空洞特性への影響 - 温度上昇 -

4 MW、パルス幅2µs入力における反射電力 と空洞内損失電力の波形



大電力入力による空洞特性への影響 - 温度上昇 -

20 K を基準とした計算結果 空洞温度上昇の入力RF電力依存性



Q値および共振周波数への影響 (20 Kを基準に定常状態からの推定)

- ・ 10 K程度の温度上昇はほぼ影響なし
 → 20 MW入力程度まで問題なし(?)
- 20 Kの温度上昇Q₀が10%低下、共振周波数が130kHz 低下しても、動作の破綻はない
 →ピーク共振周波数から130kHz低下しても空洞電界の低下は1.5%以内



Q。の低下による結合係数変化の影響



Q₀の10%低下は1次近似では電界の変化がほぼ無視できる。

空洞放電時の電界がほぼ正確に推定できる。

<u>まとめ</u>

- 20 K 冷却Cバンド光陰極RF電子銃用試験空洞の低電力試験結果に基づき 当初予定のピーク4MWを遥かに超える大電力RF入力における空洞動作を 検討。
- ・ RF入力による空洞温度上昇を評価し、空洞特性に及ぼす影響を考察。
- ・ 空洞温度の上昇10K程度までは、空洞特性の変化は小さい。
- 温度上昇が20K程度までになると、無負荷Q値の低下に伴い、加速電界の 変化は無視できるが、空洞消費電力は10%増加するため、さらに若干空洞 温度が上昇すると予想。
- ・パルス幅 2µs、ピーク40 MWの入力で空洞平均温度が20 K程度上昇。
- ・ 空洞温度上昇は、20 K冷却2.6セルRF電子銃空洞における高電界放電頻度の測定実験には支障ない。
- 低温冷却高電界RF電子銃で、短パルスレーザー照射による短バンチビーム
 生成の可能性。